800 MHz–4 GHz 50 W広帯域RFパワーアンプモジュール



800–4000 MHzで飽和出力は標準50 W、利得は標準47 dB、利得平坦度は標準±2 dBです。50 W時の電流と電力付加効率は標準7 A、20%です。

160 × 100 × 25 mmの筐体はSMA/NメスRFコネクタと7ピンD-Subを使用します。RS-485と内部プルダウン付き3.3 V TTLイネーブルに対応し、電源は24–32 VDC、10 Aを超えると停止します。

電気仕様

特記なき場合：+28.0 VDC、25 °C、50 Ω システム

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	800	-	4000	MHz
飽和 RF 出力電力	Pout	-	50	-	W
電力利得	Gp	-	47	-	dB
電力利得平坦度	Gp	-	±2	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
50 W 出力時の高調波	H	-	-12	-	dBc
スプリアス信号	Spur	-	-60	-	dBc
入出力インピーダンス	Impedance	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	24	28	32	VDC
電力付加効率	Eff	-	20	-	%
Pout = 50 W 時の消費電流	IDD	-	7	-	A

監視および保護

項目	仕様
監視	電圧、電流、出力電力、反射電力、温度
出力 VSWR 保護	出力 VSWR が 3:1～3.5:1 で停止
過温度保護	85 °C を超えると停止
電源保護	32 V 超過、24 V 未満、または誤った逆接続で停止
過電流保護	10 A を超えると停止

絶対最大定格

定格を超えるとモジュールが損傷する可能性があります

項目	定格
損傷を生じない RF 入力電力	+10 dBm
Pout = 50 W 時の負荷 VSWR	3:1、全負荷位相、連続状態
熱過負荷	85 °C で停止

環境仕様

記載の環境条件は設計目標値です。ご使用の案件に適用される条件を確認してください。

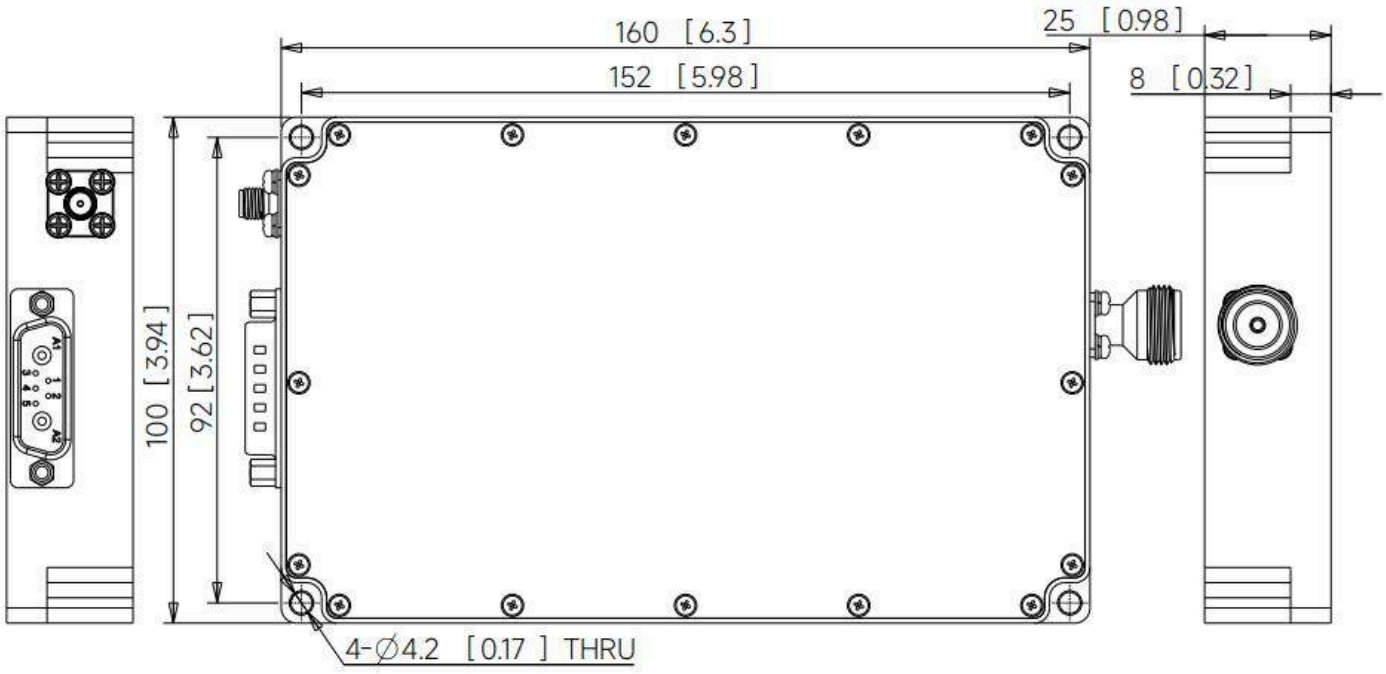
項目	最小値	代表値	最大値	単位
動作温度	-20	-	50	°C
保存温度	-25	-	65	°C
相対湿度（結露なし）	-	-	95	% RH

DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
A1	GND	グランド
A2	VDD	+28V
1	ENABLE	TTLハイレベル（3.3 V）、内部プルダウン
2	GND	グランド
3	485A	RS-485 シリアル通信
4	485B	RS-485 シリアル通信
5	NC	未接続

機械仕様

項目	値	単位
外形寸法	160 × 100 × 25[6.30 × 3.94 × 0.98] (最大値)	mm [in]
質量	1[2.2] (最大値)	kg [lb]
RF 入力コネクタ	SMA メス	-
RF 出力コネクタ	N 型メス	-
DC／制御インターフェース	ハイブリッド 7 ピン D-Sub オス	-



現在の発行記録 · 1.3 · 2026-11-11. 仕様表の内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.2.

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。